
	<h2>SI3475DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3475DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3475DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51672 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3475DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	51672 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 950mA (Tc) 2W (Ta), 3.2W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	950mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.61 Ohm @ 900mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3475DV-T1-GE3CT

SI3475DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3475DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3475DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3475DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3477DV-T1-E3 Son SI3477DV-T1-E3 Son</p>	 <p>SI3475DV VISHAY VISHAY SOT-163</p>	 <p>SI3475DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p>SI3475DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>
 <p>SI3474DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p>	 <p>SI3476DV-T1-E3 VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3475DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p>SI3476DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6</p>

heiße Teile

Mehr

SI3465DV-T1-GE3	SI3467DV	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-E3	SI3467DV-T1-GE3
SI3467DV-T1-GE3	SI3469DV-T1	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-E3	SI3469DV-T1-GE3
SI3469DV-T1-GE3	SI3471DV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-E3	SI3473CDV-T1-GE3
SI3473CDV-T1-GE3	SI3473DDV-T1-GE3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-E3	SI3473DV-T1-GE3
SI3473DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3474DV-T1-GE3	SI3475DV-T1-E3	SI3475DV-T1-GE3
SI3475DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-E3	SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3	SI3477DV-T1-E3
SI3477DV-T1-GE3	SI3477DV-T1-GE3	SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-E3	SI3481DV-T1-GE3
SI3481DV-T1-GE3	SI3483CDV-T1-E3	SI3483CDV-T1-E3	SI3483CDV-T1-GE3	SI3483CDV-T1-GE3
SI3483DV-T1-E3	SI3483DV-T1-E3	SI3483DV-T1-GE3	SI3483DV-T1-GE3	SI3493BDV-T1-E3
SI3493BDV-T1-E3	SI3493BDV-T1-E3-S	SI3493BDV-T1-GE3	SI3493BDV-T1-GE3	SI3493DDV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited